

# 加工

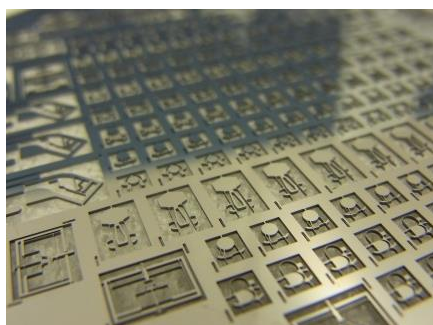
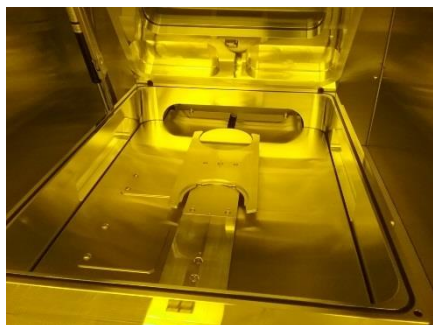
(エッチング装置群)

## シリコン深堀エッチング装置

SPPテクノロジーズ社製 MUC-21 ASE Pegasus

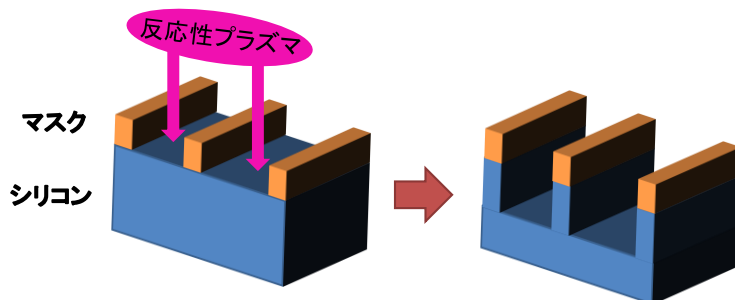
### 仕様

高周波電源	上部電極:13.56MHz, 300~2600W 下部電極:13.56MHz, 380kHz, 30~260W
反応室	不定形~4インチウエハ
使用ガス	C <sub>4</sub> F <sub>8</sub> , SF <sub>6</sub> , O <sub>2</sub> , Ar
エッチングレート	~10 μm/min



### 方向性エッチング

本装置は高密度、低圧力のプラズマによりシリコンを加工(エッチング)するドライエッチング装置です。Bosch process(ボッシュプロセス)によりSi基板に高アスペクト比の構造物が製作可能です。手動操作はロードロック上への基板の出し入れのみであり、ユーザーが設定した加工条件はPC制御により実行されます。



「文部科学省ナノテクノロジープラットフォーム事業」

微細加工プラットフォーム・香川大学



お問い合わせ先

香川大学 産学連携・知的財産センター  
ナノテクノロジー支援室

TEL/FAX:087-887-1873

E-mail: nanoplatform-c@kagawa-u.ac.jp